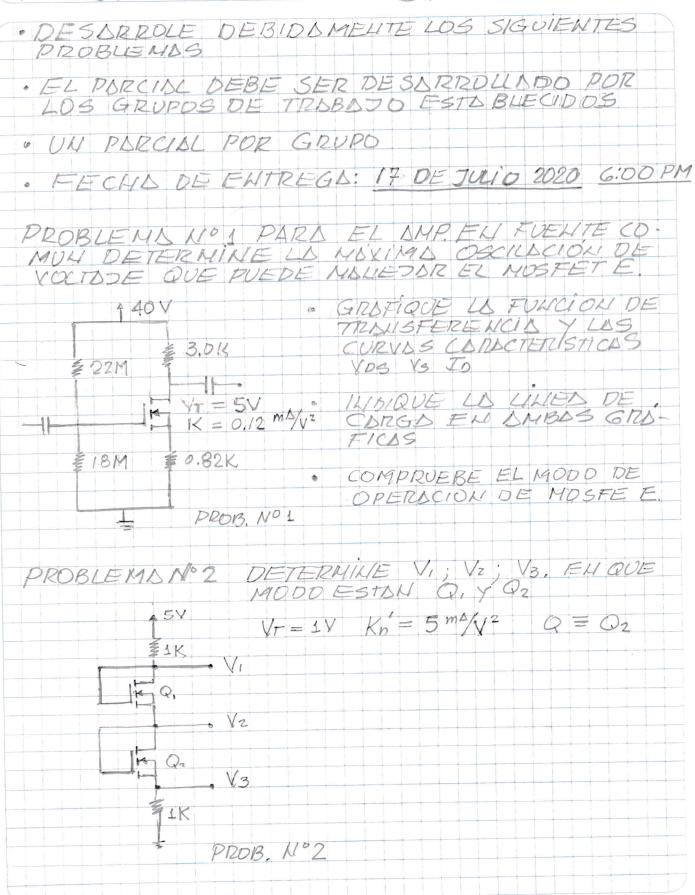
## PARCIAL Nº 4 TRANSISTOR POR EFECTO DE CAMPO I SEM 2020

11E131; 1 EE131



PROBLEMS Nº3 CONSIDERANDO UN NYUSFET E. CONI LOS SIGUIENTES DATOS DE FABRICACION SUMI-NISTRODOS POR EL FABRICALITE: L = 0.18 ym W = 2 ym Cox = 8.6 FF/ym2 un = 450 cm2/V.5 Vt = 0.5 V ECVENTRE: 0) VGS Y VOS EN LA FRONTERS DE LA REGION DE SATURACIÓN CON TO = 1004A NONTENIEUDD VGS = KTE EUCUEU TRE YOS DORA IO = 504A PARA SUSCIZAR EL USO DEL MOS-FET COMD UN AMPLIFICADOR LINES MISHTENIENDO EL MOSFET EN ENCUENTRE EL CAMBIO EN IO DE VGS DE 0.74 ±0.01 V PROBLE NO Nº 4 PARA EL AMPLIFICADOR INDICADO DETERHINE A IZV 9m 10M \$ 2K b) (d c) Zá con y sIN rd Q, ZO CON Y SIN TO PROB 1104 AV con y six rd. K = 0.24 mA/V2 VT = 3V DISENE LA RED PARA IDOFO,5 MA PROBLEMS Nº5 VD50 = 4V DSUMD UN MOSFET F CON LOS SI-GUIELITES PARDMETROS: Kn = 804A/V? W/L = 6.25 Vr = 1.2V

